

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報 (A)

(11)特許出願公表番号

特表平7-500459

第7部門第2区分

(43)公表日 平成7年(1995)1月12日

(51)Int.Cl.* 識別記号 庁内整理番号
H 01 L 21/3065
C 23 C 16/50 8116-4K
C 23 F 4/00 A 8414-4K
8719-4M H 01 L 21/302

F I

C

審査請求 有 予備審査請求 未請求(全 9 頁)

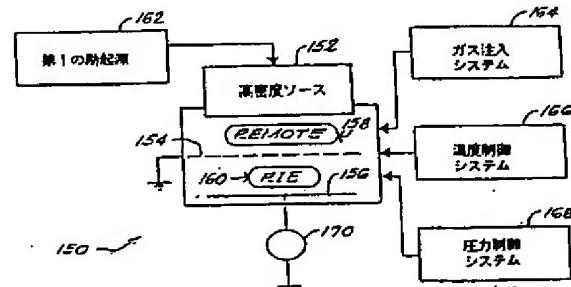
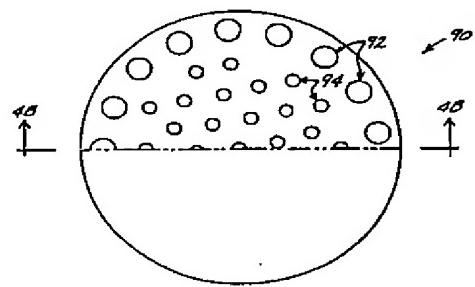
(21)出願番号 特願平6-506321
(86) (22)出願日 平成5年(1993)8月4日
(85)翻訳文提出日 平成6年(1994)4月12日
(86)国際出願番号 PCT/US93/07344
(87)国際公開番号 WO94/05035
(87)国際公開日 平成6年(1994)3月3日
(31)優先権主張番号 929,099
(32)優先日 1992年8月13日
(33)優先権主張国 米国(US)
(81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE,
DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, M
C, NL, PT, SE), JP, KR

(71)出願人 ラム リサーチ コーポレイション
アメリカ合衆国 カリフォルニア州
94538 フリーモント クーシング バー
クウェイ 4650
(72)発明者 マハー ジョセフ エイ
アメリカ合衆国 マサチューセッツ州
01982 サウス ハミルトン ベリーウッ
ド レーン 30
(72)発明者 ケント マーティン エイ
アメリカ合衆国 マサチューセッツ州
01810 アンドーヴァー コーベット ス
トリード 14
(74)代理人 弁理士 中村 稔 (外6名)

(54)【発明の名称】 中空アノードのグロー放電装置

(57)【要約】

2電極及び3電極反応炉の形態の付着及びエッティング用の中空アノードグロー放電装置は、改良された均一性、効率及び低圧力基体処理を与える。イオン優性プロセスにおいて、この装置は、多数のマルチサイズの均一離間穴(92, 94)を有する高エネルギー密度の均一化グリッド(90)を備え、更に、化学優性プロセスにおいては、装置は、多数の均一離間穴と、段状又は連続的に可変な非平面プロファイルとを有する高エネルギー密度の均一化グリッドを備え、更に、低圧力のイオン優性及び/又は化学優性プロセスにおいては、装置は、ダークスペース作用を克服するに充分な大きな巾の多数の均一サイズの離間された穴を有する高エネルギー密度のグリッドを備え、そして更に、イオン優性及び/又は化学優性のプロセスにおいては、装置は、高密度の選択されたエネルギーのイオンを発生するように相乗的に共働する高エネルギー密度源を備えている。



請求の範囲

1. イオン導性の基体表面処理装置において、

反応容器と：

この反応容器内に取り付けられた少なくとも第1及び第2の離間された電極であって、これらの電極間に基体表面処理媒体形成領域を画成するような少なくとも第1及び第2の離間された電極と；

これら電極の一方の付近にある基体ホルダーと；

基体表面処理媒体形成反応剤を上記反応容器に注入するガス注入手段と；

少なくとも1つの電気的動起源と；

該少なくとも1つの電気的動起源と上記少なくとも第1及び第2の離間された電極との間に接続されてこれら電極の片方に中空アノードグロー放電を誘起させるための結合手段とを備え；

上記電極の上記片方は、上記中空アノードグロー放電が生じるところの所定の異なる特性の少なくとも第1及び第2グループの貫通する穴を有し、これらの穴グループの穴の上記所定の異なる特性は、基体の全面にわたり実質的に均一の基体表面処理を与えるように選択されることを特徴とする装置。

2. 上記電極の上記片方は、接地された電極である請求項1に記載の発明。

3. 上記接地された電極の上記片方とも第1及び第2の穴グループの穴の上記所定の特性は、異なるサイズであるよう選択される請求項1に記載の発明。

4. 上記電極の上記片方の上記片方とも第1及び第2の穴グループの穴の上記所定の特性は、異なるサイズであるよう選択される請求項1に記載の発明。

5. 上記異なるサイズの穴グループの穴は、それに対応する中空アノードグロー放電を基体ににおいて発生させて、それら穴グループの穴のパターンが基体上に複製されるのを防止できるように選択された均一の所定の距離だけ離間される請求項4に記載の発明。

6. 上記電極の上記接地された片方は金属性プレートであり、そしてこの金属性プレートを貫通する穴グループの穴は、均一長さのものである請求項2に記載の発明。

7. 化学導性の基体表面処理装置において、

る請求項8に記載の発明。

1. 低圧力の基体処理装置において、

反応容器と：

この反応容器内に取り付けられた少なくとも第1及び第2の離間された電極であって、これらの電極間に基体表面処理媒体形成領域を画成するような少なくとも第1及び第2の離間された電極と；

これら第1及び第2の離間された電極の一方の付近に基体を解除可能に保持する基体ホルダーと；

基体表面処理反応剤を上記反応容器に注入するためのガス注入手段と；

電気的動起源と；

該電気的動起源と上記第1及び第2の離間された電極との間に接続されてこれら少なくとも第1及び第2の電極の片方に中空アノードのグロー放電を誘起させる結合手段と；

所定の圧力を選択的に確立するための圧力制御手段とを備え；

上記電極の上記片方は、上記中空アノードグロー放電が生じる少なくとも1つを貫通する穴を有し、これら少なくとも1つの穴の各々は、4. 9 mmより大きいように選択された所定の巾を有することを特徴とする装置。

1. 上記少なくとも1つの穴の各々は、1. 1 mmの巾である請求項1. 6に記載の発明。

1. 低圧力、選択されたエネルギーのイオン導性及び／又は化学導性の基体表面処理装置において、

反応容器と：

高エネルギーイオンを発生する高エネルギー源と；

互いに且つ上記高エネルギー源から離間された第1及び第2の電極であって、上記反応容器に取り付けられて、上記高エネルギー源とこれら第1及び第2の離間された電極の一方との間に第1の処理媒体形成領域を画成すると共に、これら第1と第2の離間された電極の間に第2の基体表面処理媒体形成領域を画成するような第1及び第2の電極と；

これら第1及び第2の離間された電極の一方の付近に基体を解除可能に保持す

反応容器と：

この反応容器内に取り付けられた少なくとも第1及び第2の離間された電極であって、これらの電極間に基体表面処理媒体形成領域を画成するような少なくとも第1及び第2の離間された電極と；

これら電極の一方の付近に基体を保持する基体ホルダーと；

反応剤を上記反応容器に注入するためのガス注入手段と；

電気的動起源と；

該電気的動起源と上記少なくとも第1及び第2の離間された電極との間に接続されてこれら電極の片方に中空アノードグロー放電を誘起させるような結合手段とを備え；

上記電極の上記片方は、上記中空アノードグロー放電が生じる少なくとも1つの貫通する穴を有し；

上記少なくとも第1及び第2電極の上記片方は、基体の全面にわたり実質的に均一の基体表面処理を与えるように選択された仕方で平面状態から離れた所定の非平面プロファイルを行していることを特徴とする装置。

8. 上記電極の上記片方は接地された電極である請求項7に記載の発明。

9. 上記所定の非平面プロファイルは、凹状となるように選択される請求項8に記載の発明。

10. 上記所定の非平面プロファイルは、凹状となるように選択される請求項7に記載の発明。

11. 上記所定の非平面プロファイルは、連続的な非平面となるように選択される請求項7に記載の発明。

12. 上記所定の非平面プロファイルは、個別の非平面となるように選択される請求項7に記載の発明。

13. 少なくとも1つの穴は、均一サイズの離間された複数の穴を含む請求項7に記載の発明。

14. 上記所定の非平面プロファイルは、連続的な非平面となるように選択される請求項8に記載の発明。

15. 上記所定の非平面プロファイルは、個別の非平面となるように選択され

るためのホルダーと；

電気的動起源と；

該電気的動起源と上記第1及び第2の離間された電極との間に接続されて、これら第1及び第2電極の片方に中空アノードグロー放電を誘起すると共に、上記第1の処理媒体形成領域から上記第2の処理媒体形成領域へ移動されるべき特定エネルギーのイオンを選択するための結合手段とを備え；

上記第1及び第2電極の上記片方は、中空アノードグロー放電が生じる少なくとも1つの貫通する穴を有し、これらの穴を通して、上記高エネルギー源により上記第1の基体表面処理媒体形成領域に発生された高エネルギーイオンが、上記第2の基体表面処理媒体形成領域と連通し、そして上記高エネルギー密度源が存在しないときに生じるであろう以上の割合の選択された特定エネルギーのイオンをこの第2の基体表面処理媒体形成領域に与えることにより電極の上記片方における中空アノードグロー放電を相対的に増大させることを特徴とする装置。

16. 上記高エネルギー密度源は、磁気的に増大されるソースである請求項1. 8に記載の発明。

17. 上記高エネルギー密度源は、高周波干渉ソースである請求項1. 8に記載の発明。

18. 上記高エネルギー密度源は、電子サイクロトロン共振ソースである請求項1. 8に記載の発明。

19. 上記高エネルギー密度源は、螺旋式の共振器である請求項1. 8に記載の発明。

明 標 言
中空アノードのグロー放電装置

発明の分野

本発明は、基体処理の分野に保り、より詳細には、改善された均一性、効率、及び低圧動作を与える新規なグロー放電基体表面処理装置に係る。

先行技術

単一基体の基体表面処理装置には一般に2つの形式がある。その1つの形態においては、プラズマのような基体表面処理媒体が2極管構成の2つの電極により制御可能に発生され、そしてその別の形態においては、基体表面処理媒体が3極管又は他の3極管構成の3つの電極によって制御可能に発生される。このような装置の場合に、1つ以上の選択された表面処理媒体が、半導体ウェハ又は他の材料の適当に準備された表面と相互作用されて、意图されたマイクロ構造体をそこに形成し及び/又は1つ以上の手前の基体表面処理段階から残っている不所望な残留物をそこから除去するようになる。当著者に知られた2極管及び3極管の反応炉は種々のものがあるが、とりわけ、本発明の譲受人から商業的に入手できるモデル「384」2極管反応炉及びGCAコーポレーションから商業的に入手できるモデルWafer-Etch 606/616の3極管反応炉がある。2極管反応炉の場合には、プラズマのような基体表面処理媒体が2極管構成の2つの電極間に制御可能に発生され、一方、3極管反応炉では、プラズマのような基体表面処理媒体が、上部電極とグリッド電極との間、及びグリッド電極と下部電極との間に制御可能に発生される。

2極管又は3極管のいずれの構成であっても単一基体の基体表面処理炉により制御可能に発生される基体表面処理媒体には一般に2つの形式がある。ある形式の基体表面処理、例えば、半導体ウェハ又は他の基体上の酸化物又は他の材料のエッチングを行う場合には、これら反応炉は、主として選択されたイオンによって構成された基体表面処理媒体を発生し、一方、他の形式の基体表面処理、例えば、半導体ウェハ又は他の基体上のアルミニウム又は他の材料の塩素エッチングを行う場合には、これら反応炉は、主としてある選択された化学種によって構成された基体表面処理媒体を発生する。前者の形式の処理は、「イオン優性(ion-dominated)」処理として知られており、一方、後者の形式は、「化学優性(chemically-dominated)」処理として知られている。このイオン優性及び化学優性処理は、形成される特定のマクロ構造及び全製造プロセスの段階に基づき、基体の表面上での堆積(付着、成長及びその他)、又は基体の表面からの除去(エッティング及びその他)のいずれかに制御可能に影響を及ぼし得る。

特表平7-500459 (3)

イオン優性及び化学優性の両方の処理についてこれまでに知られている2極管又は3極管構成の反応炉の有用性は、得ることのできる基体表面処理の均一性の程度に関する限度がある。例えば、より多くの集積回路が大きな半導体ウェハ上に製造される非常に大規模な集積(VLSI)に適用する場合に、製造されるデバイスの有効収率は、基体表面処理装置により得られる均一性の程度に左右される。基体当たりに製造される集積回路デバイスの収率を高めるためにウェハの半径方向サイズを増加するにつれて、ウェハ全体にわたって均一性を得ることの困難さが対応的に厳しいものとなる。デバイスの収率は、得られる均一性の程度に正比例するので、装置設計の技術は、基体表面の処理の均一性が改善されるのと同じ程度に進歩する。

2極管又は3極管のいずれの電極構成のものであれ、これまで知られている反応炉の有用性は、選択されたイオン優性及び化学優性の処理を半導体ウェハ又は他の基体において効率的に実行することのできる圧力に関して更に限度がある。例えば、非常に小さな特徴部をもつマイクロ構造体を製造することが望されるようなVLSIに適用する場合には、製造することのできる細部の微細さ及び縮尺度が反応炉内の圧力によって左右される。選択されたイオン優性及び化学優性プロセスが実行される圧力を下げるにつれて、製造することのできるマイクロ構造体の微細さ及び縮尺度は対応的に増加される。しかしながら、3極管構成の反応炉では約70mTorrそして2極管構成の反応炉では約800mTorrの圧力以下では、これまで知られている基体表面処理装置の効率が低くなり過ぎて実際的な処理を行えず、これは、所望である以上に大きく且つ荒いレベルでこれまで製造することのできたマイクロ構造体の微細さ及び縮尺度を「凍結」する。製造することのできるマイクロ構造体の微細さ及び縮尺度の程度は、これらの反応炉内の圧力レベルに逆比例するので、装置設計の技術は、低圧力処理を効率的に得るこ

とができるのと同じ程度に進歩する。

発明の要旨

従って、本発明は、その主たる目的として、2極管又は3極管又は他の多電極構成の基体表面処理装置であって、基体の堆積及び/又は除去のためのイオン優性及び/又は化学優性処理に対して改善された均一性、効率及び低圧動作を与えるような基体表面処理装置を開示する。改善された均一性のイオン優性処理に対する1つの実施例によれば、本発明の装置は、反応容器と;この反応容器内に取り付けられた少なくとも第1及び第2の離間された電極と;これら電極の一方の付近にある基体ホルダーと;基体表面処理媒体形成反応剤を上記反応容器に注入するためのガス注入手段と;少なくとも1つの電気的励起源と;少なくとも1つの電気的励起源と上記少くとも第1及び第2の離間された電極との間に接続されてこれら電極の片方を接地する一方、この接地された片方の電極に中空(ホール)アノードのグロー放電を誘起させるようにこれら電極の他方を付勢させるような結合手段とを備え;上記電極の上記接地された片方は、これを貫通する穴の少なくとも第1及び第2のグループを有し、これらの穴内で上記中空アノードグロー放電が生じるようにされ;上記少くとも第1及び第2のグループの穴は、基体の全面にわたり実質的に均一の基体表面処理を行うように選択された所定の異なる特性のものである。改善された均一性のイオン優性処理の実施例においては、上記接地された電極の少なくとも第1及び第2の穴グループの穴の所定の特性が、異なるサイズとなるように選択される。

更に、改善された均一性の化学優性処理に対する1つの実施例によれば、本発明の装置は、反応容器と;この反応容器内に取り付けられた少なくとも第1及び第2の離間された電極であって、これらの電極間に基体表面処理媒体形成領域を構成するような第1及び第2の離間された電極と;これら電極の一方の付近に基体を保持する基体ホルダーと;反応剤を上記反応容器に注入するためのガス注入手段と;電気的励起源と;該電気的励起源と上記第1及び第2の離間された電極との間に接続されてこれら電極の片方を接地する一方、これら少くとも第1及び第2の電極のこの接地された片方の電極に中空アノードのグロー放電を誘起させるようにこれら電極の他方を付勢させるような結合手段と;上記反応容器に100mTorr以下であるように選択された所定の圧力を選択的に確立するための圧力制御手段とを備え;上記電極のうちの接地された上記片方は、上記中空アノードグロー放電が生じる複数の貫通する穴を有し、これらの穴は、4.9mmより大きいように選択された所定の巾を有する。本発明によれば、この接地されたグリッド電極の穴のサイズは、中空アノードグロー放電が生じる仕方を制御し、低い圧力で基体表面処理を行えるようにすると共に、これまで可能であると考えられていた以上に対応的に細かい細部及び縮尺度のマイクロ構造体を製造できるようになる。

更に、改善された低圧力、選択されたエネルギーのイオン優性及び/又は化学優性処理に対する1つの実施例によれば、本発明の装置は、反応容器と;イオンを発生する高エネルギー源と;互いに且つ最高エネルギー源から離間された第1及び

第2の電極であって、上記反応容器に取り付けられて、上記高エネルギー源とこれら第1及び第2の離間された電極の一方との間に第1の基体表面処理媒体形成領域を構成すると共に、これら第1と第2の離間された電極との間に第2の基体表面処理媒体形成領域を構成するような第1及び第2の電極と、これら第1及び第2の離間された電極の一方の付近に基体を解除可能に保持するためのホルダーと；電気的動起源と；該電気的動起源と上記第1及び第2の離間された電極との間に接続されてこれら第1及び第2電極の片方を接地し、これら第1及び第2の電極のこの接地された片方に中空アノードのグロー放電を誘起させるようにこれら電極の他方を付勢させ、そして選択されたエネルギーのイオンを基体へと移動させるような結合手段とを備え；上記第1及び第2電極の接地された片方は、上記中空アノードのグロー放電が生じるところの複数の貫通する穴を有し、これらの穴を通して、上記高エネルギー源により上記第1の基体表面処理媒体形成領域に発生された高エネルギーイオンが、上記第2の基体表面処理媒体形成領域と連通し、そして折りの低圧動作点において存在するであろう以上の割合の選択されたエネルギーのイオンをこの第2の基体表面処理媒体形成領域に与えることにより上記中空アノードグロー放電を相乘的に増大させ、これにより、これまで可能であると考えられていたものより低い圧力及び高い密度において効率改善された選択されたエネルギーの處理を与える。高エネルギー源はこの実施例においては電磁的に増加されるソースであるが、本発明の概念から逸脱せずに、RF (高周波誘導) 及びECR (電子サイクロトロン共鳴) 又は他の高エネルギー源を使用することができる。

本発明のこれら及び他の目的、特徴、及び効果は、添付図面を参照した好ましい実施例の以下の詳細な説明により本発明が理解されるにつれて明らかとなるであろう。

図面の簡単な説明

図1は、クラサキ氏等の共通に譲渡された米国特許第5,013,400号に開示され請求された形式の典型的な公知の2極管反応炉及び3極管反応炉を各々図1A及び1Bに概略的に示した図である。

図2は、本発明の原理を説明するのに有用な図である。

るよう見え、従って、上部電極14は「アノード」と称し、そして下部の付勢される電極18は「カソード」と称する。図2Bにより概略的に示されそして「RIE」と表示された反応性イオンエッティング(RIE) プラズマは、良く知られたように反応炉10の反応容器12内でアノード14とカソード16との間に制御可能に発生される。

図1Bの概略図には、参考としてここに取り上げる1991年5月7日付けのクラサキ氏等の「シャンパンプロファイルを形成する乾燥エッティングプロセス、及び乾燥エッティング装置(DRY ETCH PROCESS FOR FORMING CHAMPAGNE PROFILES, AND DRY ETCH APPARATUS)」と題する共通に譲渡された米国特許第5,013,400号に開示された形式の3極管反応炉が3-0で一般的に示されている。この3極管反応炉3-0は、上部電極3-4、接地されたグリッド3-6及び下部電極3-8が3極管構成で離間関係に取り付けられた反応容器3-2を備えている。上部電極3-4及び下部電極3-8は、「RF」と示された電気動起源4-0に、各々、可変キャバシタ「C1」及び「C2」を経、電気動起源4-0に並列的なキャバシタ「C」及び直列インダクタ「L」を含む回路に沿って接続される。

ガス注入システム4-2は、気相の選択された反応剤を制御可能に注入するため反応容器3-2に接続され、温度制御システム4-4は、容器3-2の温度及びその電極の温度を制御するために反応容器3-2に接続され、そして圧力制御システム4-6は、選択された動作圧力を確立して維持するために反応容器3-2に接続される。好ましい実施例では、ガス注入システム4-2は、上部電極3-4とグリッド3-6との間に配置されたガス拡散器(図示せず)を備えており、そして上部電極3-4には複数の貫通する穴(図示せず)が設けられており、注入されたガスはこれら穴を通して反応容器3-2へ流れ込む。

好ましい実施例の温度制御システム4-4は、上部電極3-4の温度を制御するために水のような熱伝送流体を循環することのできる回路(図示せず)を上部電極3-4内に含んでいる。又、反応容器の温度を制御するための抵抗加熱素子を受け入れるボア(図示せず)が容器3-2に設けられるのが好ましく、そして下部電極3-8には、旗下部電極の温度を制御するためにヘリウムのような熱伝送流体を循環できるボア(図示せず)が設けられる。又、下部電極3-8は、その温度を制御す

るため水のような熱伝送流体を循環できる穴(図示せず)も有している。

グリッド電極3-6は、図示されたように電磁的に接地される。この電極には、巾が4.9mm以下の穴が均一に設けられる。電気動起源4-0は、可変キャバシタ「C1」及び「C2」を経て上部電極3-4及び下部電極3-8に接続され、上部電極3-4とグリッド3-6との間に「REMOTE」と表示されたプラズマ4-8のみを選択的に形成し、グリッド3-6と下部電極3-8との間に「RIE」と表示されたプラズマ5-0のみを形成し、そして上部電極3-4とグリッド3-6との間に及びグリッド3-6と下部電極3-8との間にプラズマを形成することができるようになる。

好ましい実施例の圧力制御システム4-6は、好ましくは反応容器3-2内に配置されたU字型圧力計(図示せず)からフィードバックを受け取る圧力制御器(図示せず)を備えている。この制御器は、5.0mTorrないし3000mTorrの圧力範囲から選択されたチャンバ設定圧力に応答すると共に、U字型圧力計により供給される圧力の読みに応答して、反応容器3-2とポンプ(図示せず)との間に接続されたオリフィスバルブ(図示せず)を制御可能に較り、対応する設定圧力を反応容器3-2に確実し維持する。もちろん、1Torrないし10000mTorrの別の圧力範囲を設けることもできる。

図1Bの3極管反応炉3-0の1つの動作モードにおいては、グリッド3-6を接地した状態で下部電極3-8に全電力を供給するが上部電極3-4には電力を供給しないことにより、RIEプラズマ5-0のみが形成される。図1Bのいわゆる3極管反応炉3-0と、電極14と16との間にRIEプラズマ2-6を同様に形成する図1Aの2極管反応炉1-0は、同一の電極及びプラズマ構成を有している。しかしながら、2極管反応炉1-0と、2極管反応炉として動作される3極管反応炉3-0において同じ反応が行われるときには、2極管反応炉1-0と、2極管反応炉として構成された3極管反応炉3-0は、意外なことに、かなり異なるプロセス特性を生じることが分かった。例えば、C₁F₆をSiO₂と反応させて、図1A及び1Bの2極管反応炉1-0及び2極管として動作する3極管反応炉3-0の双方において二酸化シリコンエッティングを行うような例示的なエッティングの場合に、2極管反応炉1-0のエッティング割合は、該2極管反応炉の圧力が減少するにつれ

特表平7-500459 (5)

で減少するように測定されたが、2 横管反応炉として構成された 3 横管反応炉 3 0 は、圧力が減少するにも係わらずそのエッチング割合を比較的高いレベルに維持する。約 1.00 aTorr 以下では、エッチング割合は、2 横管反応炉 1 0 の場合に毎分数百人には過ぎないが、2 横管反応炉として構成された 3 横管反応炉 3 0 の場合にはほぼ同じ 1.00 aTorr において、エッチング割合は、毎分数千人程度に保たれ、2 横管反応が 1 0 での標準的な RIE エッチングよりも約 2.0 倍も優れている。

圧力性能についてのこの意外な相違に加えて、図 1 B の 3 横管反応炉 3 0 が 2 横管反応炉として構成されて動作されるにも係わりなく、図 1 A の 2 横管反応炉 1 0 の同じ例示的エッチングに対して示される均一性は、図 1 B の 3 横管反応炉 3 0 によって与えられる均一性と異なることが分かった。図 1 A の 2 横管反応炉 1 0 の場合には、エッチング割合は、ウェハの中央部又はその付近の領域では高いがその縁においては低く； 2 横管反応炉として動作する図 1 B の 3 横管反応炉 3 0 の場合には、均一性それ自体はウェハを横切って維持されるが、図 1 A の 2 横管反応炉 1 0 ののようにその中央部と縁との間で同じ変化を示さない。

本発明は、エッチング割合及び均一性のこれら及び他の相違がここに述べる中空アノードグロー放電に起因するもので、このグロー放電は図 1 B の 3 横管反応が 3 0 のグリッドの空所それ自身に生じて、RIE プラズマを支配し且つエッチング割合を持続すると共に、図 1 A の 2 横管反応が 1 0 の同じ RIE プラズマが処理の均一性を歪め及び／又はそれ自体を消滅するような低い圧力でも均一性を発揮するものであることを認識することに至っている。これまで認識されていないこの現象は、改善された均一性、効率及び低圧動作を与えるグロー放電装置を本発明に上って構成できるようになる。

図 2 を参照すれば、本発明の原理を解明するのに有用な構成が 6 0 で一般的に示されている。3 横管反応が 3 0 (図 1 B) の一般的に 6 2 で示す付勢された下部電極と、一般的に 6 4 で示す接地されたグリッドとの間に、「E」を表示された電界 6 6 が示している。「e」を表示された円 6 8 によって概略的に示された電子は、電極 6 2 と 6 4 との間に定められた RIE プラズマ形成領域に存在するもので、電界 6 6 によってグリッド 6 4 へ加速される。電子 6 8 の幾つかは、

グリッド 6 4 を貫通する一般的に 7 0 で示された少なくとも 1 つの穴を画成する内壁に衝突し、このような各電子 6 8 に対し、「e」と表示された円で概略的に示された複数の電子 7 2 が二次放出プロセスによって発生される。これらの二次電子 7 2 は、次いで、少なくとも 1 つの穴 7 0 の各々に捕えられ、穴を画成する直面する内壁間で前後に振動する。

この振動する二次電子 7 2 は、少なくとも 1 つの穴 7 0 の空所内に存在するガス分子と衝突し、「+」を表示された円 7 4 で概略的に示された多数のイオンを発生する。二次電子及びイオン発生プロセスは、アバランチ (なだれ) 及びブレークダウンを生じ、少なくとも 1 つの穴 7 0 各々の軸に沿って電子密度が高いことを特徴とする中空アノードグロー放電が、少なくとも 1 つの穴 7 0 の各空所に形成される。

本発明によれば、少なくとも 1 つの穴 7 0 の各々の周囲には、被験 7 6 で概略的に示され、「V_{on}」と表示された電位をもつ無グローのダークスペースシースが形成される。各穴 7 0 におけるグロー放電の強度は穴のサイズに関係しており、ダークスペースシース 7 6 の空間の強度は、対応する穴 7 0 の圧力に逆に関係している。又、典型的に負の直流バイアス電圧を使用する付勢された電極 6 2 の周囲には、被験 8 0 で概略的に示され、「V_{off}」と表示された電位をもつ無グローのダークスペースシースが形成される。

図 3 は、その図 3 A ないし 3 D において、飽和イオン電流の変化を縦軸にプロットしそして反応炉における Z 位置を横軸にプロットしたものをしており、ここで、1. 5 の横軸値は、例示的 C, F, の化学反応に対する反応炉内のグリッド位置に対応し、そして縦軸の値は Z プロフィルメータによって測定されたものである。「穴なし」グリッドに対しイオン電流を Z の位置と共に示した図 3 A のグラフ 8 2 によって示されたように、イオン電流は、グリッドの下の領域に対し、1.50 マイクロアンペア未満でピークとなる。各々 7 mm, 1.1 mm 及び 1.7 mm 直径の複数の均一サイズの貫通穴を有するグリッドに対応する図 3 B, 3 C 及び 3 D のグラフ 8 4, 8 6 及び 8 8 は、グリッドを貫通する穴のサイズが変化するにつれて飽和イオン電流がいかに変化するかを表している。グラフ 8 4, 8 6 及び 8 8 の各々のイオン電流は、グリッド位置において、例示的 C, F,

の化学反応の場合に付与された電力によって決まる最大値でピークとなる (1.00, 2.00 及び 3.00 ワットにおける多数のピークを比較されたい)。

図 4 を参照すれば、本発明によるイオン活性化処理のための高エネルギー密度の均一化グリッドが 9 0 で一般的に示されている。この好ましい実施例のグリッド 9 0 は、図 1 B の 3 横管反応が 3 0 内に取り付けられるが、本発明の概念から逸脱することなく、図 1 A の 2 横管反応が 1 0, 或いは 2 横管、3 横管又は他の多電極反応炉として構成された何らかの他の反応炉内に取り付けることができる。どのような反応炉に取り付けられようと、グリッド 9 0 が接地されそして基体支持電極が付勢されて、その各々の穴に中空アノードグロー放電を誘起するのが好ましい。

グリッド 9 0 は、各々 9.2, 9.4 で一般的に示された少なくとも第 1 及び第 2 グループの貫通する穴を行し、これらの穴グループは、高エネルギー密度の中空アノードグロー放電が生じるところの所定の異なる特性を有している。穴のサイズを変えることにより、高エネルギー密度の中空アノードグロー放電の強度が変えられ (図 3 を比較)、そして少なくとも第 1 及び第 2 グループの穴 9.2, 9.4 の所定の異なる特性は、基体の全面にわたる実質的に均一の基体表面処理を与えるように選択される。好ましい実施例では、この特性は、少なくとも第 1 及び第 2 グループの穴 9.2, 9.4 の穴が各々異なるように選択される。図示されたように異なるサイズの穴 9.2, 9.4 の同心的に配列されたグループを有するグリッド 9 0 は、図 1 について説明した例示的なイオン活性化エッチングに対し実質的な均一性を与える。異なるサイズの穴の別の配列及び異なるサイズの穴の 3 つ以上のグループも、本発明の概念から逸脱せずに、使用することができる。

グリッド 9 0 の多数の穴の各々に生じる中空アノードグロー放電は、グリッドから基体に向かって下方に進み、基体の直面する表面に接近するにつれて強度が低下すると共に膨張する。基体上に穴のパターンが複製されるのを防止するためには、同じサイズの穴の穴間隔と異なるサイズの穴の穴間隔は、「D」と表示された最小寸法 9.8 が、グループ間及びグループ穴間の多数の中空アノードグロー放電を基体表面において重複させるよう確保するように選択されるのが好ましい。ここに示す実施例では、寸法 9.8 が約 0.2 mm であるが、選択された特定

のイオン活性化プロセスに基づいて穴パターンの複製を防止するように別の穴間隔を使用してもよい。好ましい実施例では、同じサイズ及び異なるサイズの穴間の間隔は、ウェハ又は他の基体上に穴のパターンが複製されるのを防止するために同じ寸法で選択されるが、少なくとも第 1 及び第 2 の穴グループの穴のパターンが基体上に複製されない限り、本発明により他の穴間隔構成を使用することができます。

グリッド 9 0 の「T」を表示された厚み 1.04 は、多数の穴における中空アノードグロー放電を維持しないほど薄過ぎることなく、しかもこれを消滅するほど厚過ぎることないようにすればよい。ここに示す実施例 9 0 では、0.12 m ないし 0.3 mm の厚みが有効であると分かっているが、本発明の概念から逸脱せずに他の厚みを使用することもできる。グリッド 9 0 の材料としては、変形や溶融を生じることのないアルミニウムのような適当な材料が選択される。

図 5 を参照すれば、本発明による例示的なイオン活性化プロセスのための高エネルギー密度の均一化グリッドの構成原理を説明するのに有用なグラフが 1.1 0 で一般的に示されている。例示的なイオン活性化プロセスは、化学試薬 C, F, 上の半導体ウェハのエッチングである。グラフ 1.1 0 は、横軸に選択された特定の基体表面プロセスの指数、ここでは「エッチング割合」を、横軸である穴サイズの増加と共にプロットしている。

グラフ 1.1 0 は、本発明によるイオン活性化プロセスのための高エネルギー密度の均一化グリッドを構成するのに使用される 1 つの手順の例である。意図された圧力に対し、種々の均一サイズ穴をもつ種々のグリッドが図 1 B の 3 横管反応が 3 0 に多数取り付けられ、種々の均一サイズ穴の各グリッドに対して得られるエッチング割合の測定値がとられる。グラフ 1.1 0 では、これらのエッチング割合が内実のボックスで概略的に示されたデータ点としてプロットされている。低い圧力の設定点はグラフ 1.1 0 を右へシフトし、高い圧力の設定点はグラフ 1.1 0 を左へシフトさせる。均一化グリッドを設計するためには、グラフ 1.1 0 の中点におけるような 1 つの選択されたサイズの穴のグリッドを用いて基体にわたるエッチング割合についての均一性的プロフィルメータ測定値がとられる。意図されたエッチング割合の上下での均一状態からのずれは、グラフ 1.1 0 を参照しそし

特表平7-500459 (B)

てエッティング割合が均一状態からずれる領域に対して意図されたエッティング割合を与える穴サイズを選択することによって補償される。次いで、均一性を与えるように選択された種々のサイズの穴のグループをもつグリッドが構成され、プロフィルメータの測定が行われ、そして実質的な均一性が得られるまで同じプロセスが繰り返される。グラフ110は単なる例示に過ぎず、本発明のイオン優先プロセスのための高エネルギー密度の均一化グリッドは、本発明の概念から逸脱せずに、他の制御グリッド及び設計方法論により、且つ異なる寸法及びパラメータについての他の種類のデータをグラフ110に示されたものとは異なる方向に沿って収集することにより、他のイオン優先プロセスに対して設計できることが明らかであろう。

図6を参照すれば、本発明による化学優性処理のための高エネルギー密度の均一化グリッドが120で一般的に示されている。図4の実施例のイオン優先処理のための高エネルギー密度の均一化グリッド90の場合と同様に、グリッド120は、適当な2電極、3電極又は他の多電極反応炉に取り付けられ。図1Bの3極管反応炉がここに示す好ましい実施例である。図4の実施例のイオン優先処理のための高エネルギー密度の均一化グリッド90の場合とは異なり、即ち高エネルギー密度の中空アノードグロー放電の相対的な強度を決定するのが異なる穴サイズであって、これが基体表面処理の実質的な均一性を与えるように選択される場合とは異なり、化学優先処理のための図6の実施例のグリッド120は、選択された化学優性プロセスに対して処理される基体の全表面にわたり実質的に均一な基体表面処理を与えるように選択された仕方で平面状態から外れた所定の非平面プロファイルを有している。本発明によれば、中空アノードグロー放電の局所的な強度は、処理されるべき基体からグリッドまでの局所的な間隔によって決定され、この間隔を制御可能に変えることにより、選択された化学優性プロセスに対し実質的に均一な基体表面処理を行なうことができる。

ここに示す実施例では、均一化グリッド120は、アルミニウムのような導体122を含み、これを通して一般的に124で示す複数の等サイズ穴が均一間隔で設けられる。ここに示す実施例では、グリッド120の所定の非平面プロファイルは、二次元的に連続弓形とされて、中央に位置する穴は周囲に位置する

である。選択された特定の化学優性プロセスは、アルミニウムエッティングであった。

使用されたサンプルは、6インチアルミニウム0.5%Cuのウェハで、200°CにおいてDUV(深紫外線)ペーニングされたものであった。3つの複製点をもつ3ファクタ二次式(quadratic)設計を使用して、18回繰り返しの実験を行った。この実験中一定に保持したのは、5.0ccmのC1、1.5ccmのSiCl4、3.0W、及び10torrのHe背蔵であった。変更したファクタは、圧力(6.0ml-12.0ml)、電極間隔(0.25インチ-1.25インチ)、及び接地されたグリッドの穴サイズ(3/18インチ-6/8インチ)であった。全てのウェハは部分的にエッティングされ、各ウェハの直径に沿った14の点においてプロフィルメータの測定が行われた。これらの測定は、エッティングの前、エッティングの後、及びレジストの剥離後に実行された。このデータから、アルミニウム(A1)のエッティング割合及びレジストのエッティング割合が各ウェハ上の14の各点において計算された。測定された応答は、ウェハにわたる平均アルミニウム及びレジストエッティング割合と、エッティング割合の均一性であった。均一性についての詳細な図は、ウェハの縁から中心までの7つの点におけるエッティング割合を回答として使用して実験結果を分析することにより得られた。これらプロットによるデータを用いて、図7の曲線132、134、136を形成し、所与のエッティング割合に対し電極間隔をウェハ位置と共にプロットした。各曲線のデータ点を輪郭プロットにマーキし、曲線がいかに形成されたかを示した。これら曲線は、ウェハ上の特定の位置において特定のエッティング割合を生じさせるのにどんな間隔が必要かを示している。又、これら曲線は、選択された例示的な化学優性プロセスに対しウェハにわたって均一なエッティング割合を生じるのに必要な接地グリッドの形状を表している。又、本発明の概念から逸脱することなく、他の化学優性処理、他の制御グリッド及び設計方法論、並びに図7以外のデータを収集する方法も使用することができよう。

図8を参照すれば、本発明による高エネルギー密度低圧力のグリッドが140で一般的に示されている。このグリッド140は、好ましくは図1Bの3極管反応炉30内に取り付けられるが、本発明の概念から逸脱することなく、図1Aの

穴よりも基体から更に離間されるように選択される。グリッド120の厚みは、均一化グリッド120が溶融するように薄過ぎてはならず、しかも高エネルギー密度のグロー放電がそれ自身で消滅するように厚過ぎてもならない。典型的な厚みの値は、0.12mmないし6.3mmであるが、本発明の概念から逸脱せずに他の厚みを使用することもできる。

選択されたいかなる化学優性プロセスの場合も、非平面プロファイルは、その選択された化学優性プロセスに対しウェハの全面に実質的な均一性を与えるように選択される。選択された特定の化学優性プロセスに対応する特定の非平面プロファイルを決定するために、その選択された化学優性プロセスの指數の測定が、基体の全面の周りの離間された点において、基体から第1の所定の距離に取り付けられた平面グリッドを使用して行われる。この平面グリッドは、次いで、反応炉において、基体から異なる所定の距離に取り付け直され、その選択された特定の化学優性プロセスの指數が同じ基体点において測定される。同じ1組の基体点に対して、平面グリッドを取り付け直して、その選択された化学優性プロセスの指數を測定する工程は、所定の回数繰り返される。基体の同じ点の周りの位置での指數測定値の各組は、実質的に一定の指數に対する基体から非平面グリッドまでの間隔の特定値によってパラメータ化され、各点において同じ指數を与える間隔は、直接得られるか、又は測定値からの外挿もしくは他の計算技術によって得られる。この間隔は、選択された特定の化学優性プロセスに対し実質的な均一性を与えるために非平面プロファイルを平面状態からいかにずらすかを特定するものである。ここに示す実施例の凹状グリッド120以外の個別の《形状の》非平面プロファイルや連続的な非平面プロファイルを、本発明の概念から逸脱せずに使用することができる。

図7を参照すれば、130で一般的に示されたグラフは、電極間隔(インチ)を縦軸にそしてウェハの縁からの位置(ミリメートル)を横軸にプロットしたもので、曲線132、134及び136で示されたように種々の圧力における種々の均一エッティング割合に対してパラメータ化したものである。グラフ130は、接地されたグリッドが上部電極から懸架され、テフロンのバッフルが側部を取り巻くような静電チャックをもつ変形2極管チャンバーにおいて実験的に行なわれたもの

である。選択された特定の化学優性プロセスは、アルミニウムエッティングであった。

使用されたサンプルは、6インチアルミニウム0.5%Cuのウェハで、200°CにおいてDUV(深紫外線)ペーニングされたものであった。3つの複製点をもつ3ファクタ二次式(quadratic)設計を使用して、18回繰り返しの実験を行った。この実験中一定に保持したのは、5.0ccmのC1、1.5ccmのSiCl4、3.0W、及び10torrのHe背蔵であった。変更したファクタは、圧力(6.0ml-12.0ml)、電極間隔(0.25インチ-1.25インチ)、及び接地されたグリッドの穴サイズ(3/18インチ-6/8インチ)であった。全てのウェハは部分的にエッティングされ、各ウェハの直径に沿った14の点においてプロフィルメータの測定が行われた。これらの測定は、エッティングの前、エッティングの後、及びレジストの剥離後に実行された。このデータから、アルミニウム(A1)のエッティング割合及びレジストのエッティング割合が各ウェハ上の14の各点において計算された。測定された応答は、ウェハにわたる平均アルミニウム及びレジストエッティング割合と、エッティング割合の均一性であった。均一性についての詳細な図は、ウェハの縁から中心までの7つの点におけるエッティング割合を回答として使用して実験結果を分析することにより得られた。これら曲線は、ウェハ上の特定の位置において特定のエッティング割合を生じさせるのにどんな間隔が必要かを示している。又、これら曲線は、選択された例示的な化学優性プロセスに対しウェハにわたって均一なエッティング割合を生じるのに必要な接地グリッドの形状を表している。又、本発明の概念から逸脱することなく、他の化学優性処理、他の制御グリッド及び設計方法論、並びに図7以外のデータを収集する方法も使用することができよう。

木発明によれば、これまでの最小圧力よりも低い圧力においてグリッドの空所にそのサイズのダクススペースが生じるにも係わらず、グリッド140の中空アノードグロー放電がそれ自身を維持するに充分なほど穴が大きく、従って、グリッド140を有する図1Bの3極管反応炉30は、これまでの最小圧力より低く選択された圧力において基体表面処理を行うことができる。本発明によるグリッド140は、このように、これまで不可能と考えられていた圧力の範囲で基体表面処理を行うことができ、従って、これまで考えられなかった形式、縮尺度及び微細さのマイクロ構造体を製造することができる。これまで存在する3極管反応炉では、グリッドの穴が4.9mmより大きいものはない。上記したように、圧力及び付与された高周波駆動の両方の間数であるグリッドの穴のダクススペースは、圧力の減少と共に増加する。これまでの穴サイズの場合には、穴のダクススペースは、これまでの最小圧力レベルにおいて接地グリッドの中空アノードグロー放電を実際に消滅させるか及び/又は歪めるものであり、従って、形成することのできるマイクロ構造体の幾何学形状は、現在及び将来のVLSI及び他の用途に所要される以上の大きさに「凍結」されている。

木発明によれば、これまでの最小圧力よりも低い圧力においてグリッドの空所にそのサイズのダクススペースが生じるにも係わらず、グリッド140の中空アノードグロー放電がそれ自身を維持するに充分なほど穴が大きく、従って、グリッド140を有する図1Bの3極管反応炉30は、これまでの最小圧力より低く選択された圧力において基体表面処理を行うことができる。本発明によるグリッド140は、このように、これまで不可能と考えられていた圧力の範囲で基体表面処理を行うことができ、従って、これまで考えられなかった形式、縮尺度及び微細さのマイクロ構造体を製造することができる。グリッド140のここに示す

特表平7-500459 (7)

実施例では11mmの穴巾が好ましいが、4.9mmの最小巾より大きい他の穴巾でも、プラズマが形成されると共に、これまで可能であると考えられていた大きさよりも少なくとも1桁大きいイオン密度の対応的な増加が与えられる。

図9を参照すれば、改良された低圧力、選択エネルギーイオン優性及び／又は化学優性処理のための本発明の実施例が150で一般的に示されている。図1Bの3管板反応炉30の上部電極34に代わり、反応容器の内側に接地されたグリッド154と離間関係で高密度ソース152が設けられ、グリッド154は、次いで、下部電極156と離間関係にされる。高密度ソース152とグリッド154との間には、一般的に158で示されそして「REMOTE」と表示された第1の基体表面処理媒体形成領域が設けられ、そしてグリッド154と下部電極156との間には、一般的に160で示され、「RIE」と表示された第2の基体表面処理媒体形成領域が設けられる。高密度ソースは、高周波誘導(RFI)ソース、電子サイクロトロン共振(ECR)ソース、磁気の増大ソース、及びとりわけ当業者によく知られた螺旋共振器のような何らかの適当なソースでよい。

第1の励起源162は、高密度ソース152に接続されて、これを付勢する。図1Bの要素42、44及び46に対応するガス注入システム164、温度制御システム166及び圧力制御システム168が反応容器に接続され、そして図1Bの実施例30と実質的に同様に機能するが、説明簡略化のため、ここで再び詳細に説明はしない。

高エネルギー密度のソース152は、接地されたグリッド154により発生される中空アノードグロー放電の効率を上昇させ、即ち第1の基体表面処理媒体形成領域158において高密度ソース152によって発生される高エネルギーイオンは、グリッド154の穴を通して第2の基体表面処理媒体形成領域160に連通し、そして所与の低圧力動作点において存在し得る以上の比較的大きな割合の選択されたエネルギーのイオンをこの第2の基体表面処理領域に与えることによりグリッド154の中空アノードグロー放電を相乘的に増大する。高密度ソース152のイオンは、接地されたグリッドの中空アノードグロー放電と相乘的に協働し、より大きな割合のイオンを領域160に与え、これライオンは、制御可能な負のRFソース170により下部電極156を制御可能にバイアスすることに

より選択的に抽出される。制御可能なソース170は、上部領域158から特定エネルギーレベルのイオンを抽出するように大きさが変えられる負の電位を発生する。例えば、ポリシリコンのエッティングにおいて、薄膜の非等方性エッティングを行うに必要な最小イオンエネルギーを使用することが希望される場合には、任何の堆積及びゲート酸化物のダメージを防止するために最小エネルギーイオンを選択することが所望され、この最小エネルギーイオンは、選択されたエネルギーのイオンを開始する対応する負の電位を下部電極に印加するようイオンセレクタ170の電位を変えることにより容易に選択することができる。もちろん、本発明の概念から逸脱せずに、実施例150の他の適用もなし得る。

上記した実施例では、グリッドが接地された状態で、好ましいバイアスが中空アノードグロー放電を与えたが、本発明の概念から逸脱せずに、グリッドが付勢され、そして例えば、薄膜除去のための中空カソードグロー放電が形成されてもよいことが理解されよう。以上に述べた多数の実施例における本発明の装置、例えば、主としてイオン優性プロセスのためのグリッド実施例90(図4)及び主として化学優性プロセスのためのグリッド実施例120(図6)は、本発明の概念から逸脱せずに、例えば、高エネルギー密度の均一化グリッド90又は120を反応炉150(図9)に設けることによって結合されてもよいことが理解されよう。

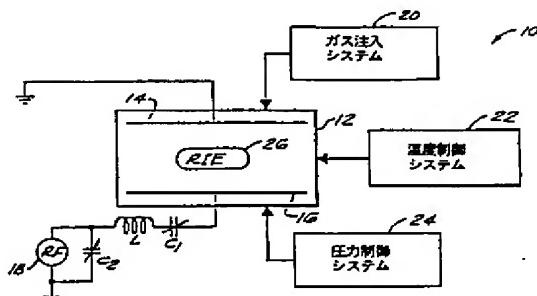


FIG. 1A

(従来例)

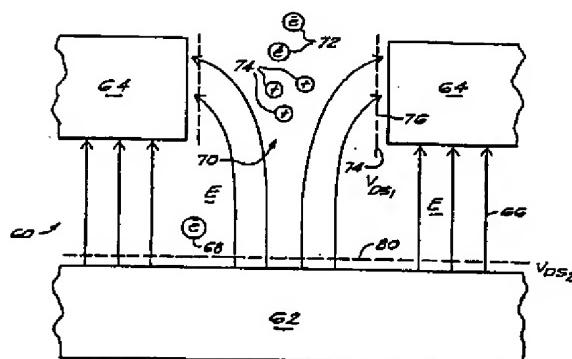


FIG. 2

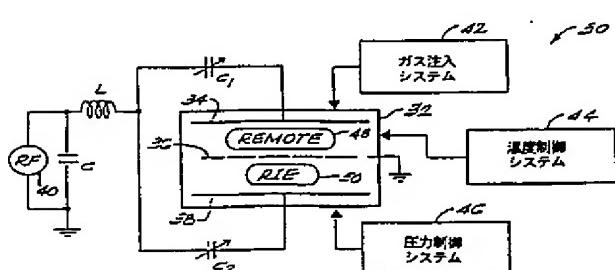


FIG. 1B

(従来例)

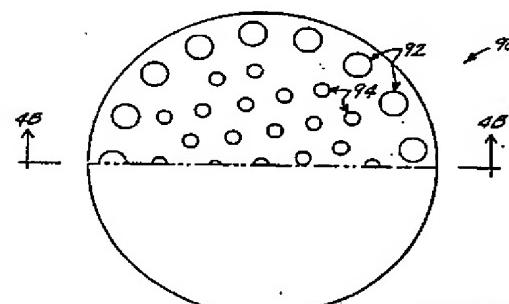


FIG. 4A

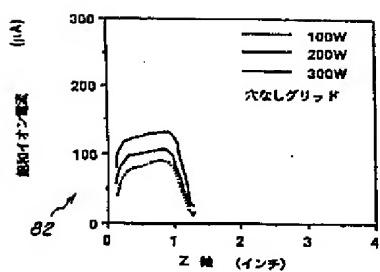


FIG. 3A

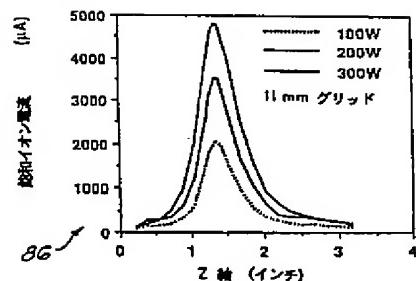


FIG. 3C

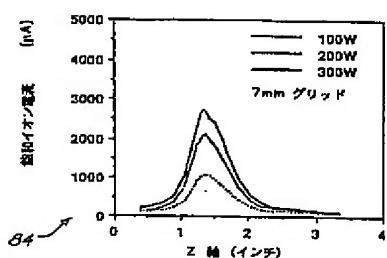


FIG. 3B

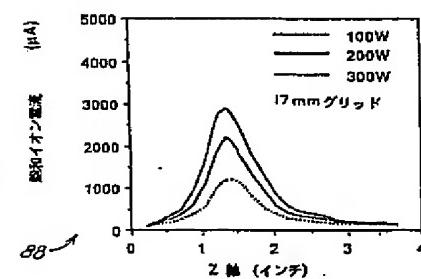


FIG. 3D

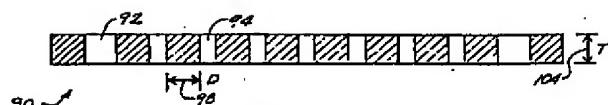


FIG. 4B

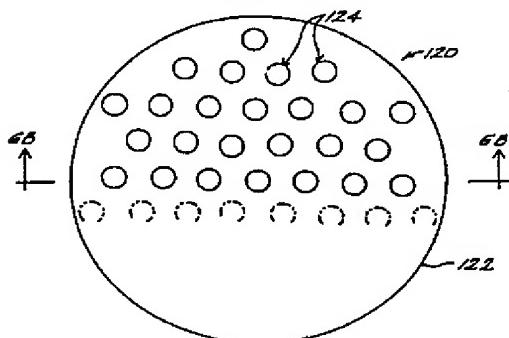


FIG. 6A

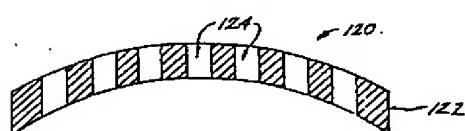


FIG. 6B

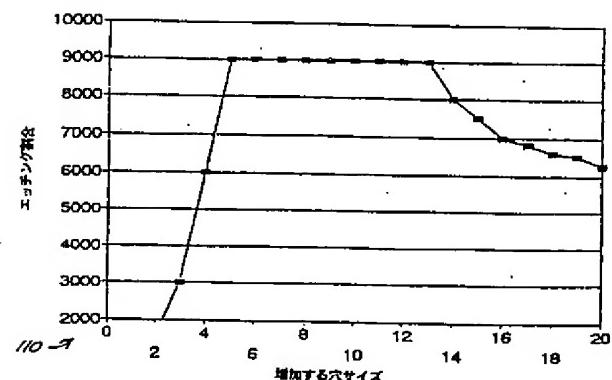


FIG. 5

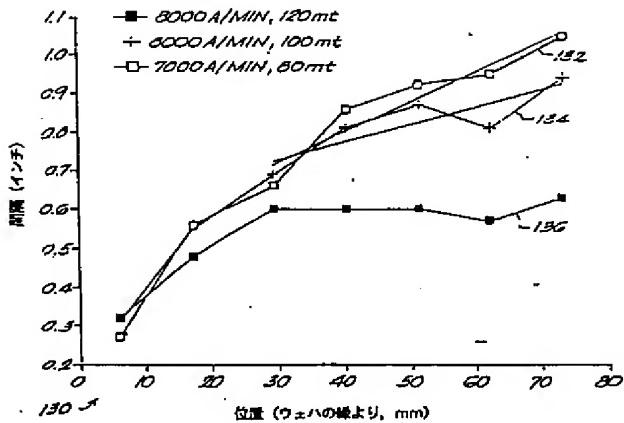


FIG. 7

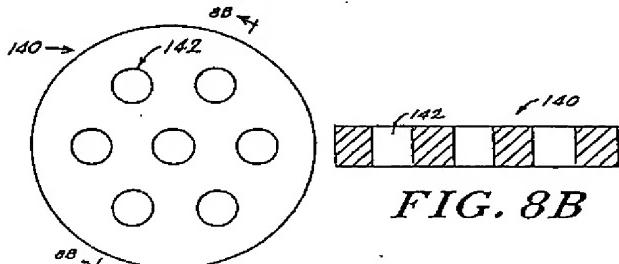


FIG. 8A

FIG. 8B

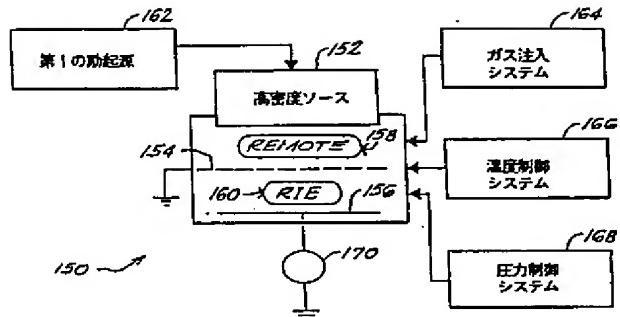


FIG. 9

国際検索報告		International application No. PCT/US93/07344
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC5 : H01L 21/00 US CL : 156/35, 43; 116/733P, 725E, 726E According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (clarification system followed by classification symbols) U.S. : 156/343, 647; 116/715, 723MP, 722E, 204/295.31, 294.33, 294.34		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are evaluated in the fields searched		
Electronic data base searched during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Classification of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage	Relevant to claim No.
A	US, A, 4,631,105 (Carroll et al) 23 December 1985.	
A	US, A, 4,792,378 (Rose et al) 20 December 1988.	
A	US, A, 4,780,159 (Stark et al) 25 October 1990.	
A	US, A, 4,957,588 (Koshiba et al) 18 September 1990.	
A	US, A, 4,971,653 (Povell et al) 20 November 1990.	
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See parent family sheet.		
* Special attention is given to documents which may be prior art to the claimed invention either because they were published after the International filing date of priority or because they contain features which are essential for understanding the claimed invention. ** Document published before the International filing date of priority but nevertheless considered to be relevant because it contains features which are essential for understanding the claimed invention. *** Document published before the International filing date of priority but nevertheless considered to be relevant because it contains features which are essential for understanding the claimed invention. **** Document published before the International filing date of priority but nevertheless considered to be relevant because it contains features which are essential for understanding the claimed invention.		
Date of the initial interpretation of the international search 17 September 1993		Date of mailing of the International search report 30 NOV 1993
Name and mailing address of the ISA/US Commissioner of Patents and Trademarks Box PCT Washington, D.C. 20530		Authorized officer <i>[Signature]</i> JOHATHAN D. BARRY Telephone No. (202) 305-0441
Patent No. NOT APPLICABLE		
Form PCT/ISA/210 (continuation of request sheet July 1993)		

International application No. PCT/US93/07344		
C (continued). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category	Classification of document, with indication, where appropriate, of the relevant passage	Relevant to claim No.
A	US, A, 4,854,263 (Chang et al) 06 August 1989.	
A	US, A, 4,349,409 (Shibayama et al) 14 September 1982.	
A	JP, A, D14481 (Sugawara) 09 January 1989.	
A	JP, A, 61239626 (Sasaki) 24 October 1986.	
A	JP, A, 6039832 (Yoshizawa) 01 March 1985.	
A	JP, A, 0150335 (Sudo) 27 February 1989.	
A	JP, A, 0219129 (Fujiyama) 23 January 1990.	
A	JP, A, 61286227 (Tomita) 12 December 1987.	